【筑波　GaN基盤製造のフォトリソグラフィ工程における生産技術】ご経験者を募集しています。

国内最大手の石油化学メーカー

Job Information

Recruiter
GLOBAL RESEARCH INC.

Hiring Company
国内最大手の石油化学メーカー

Job ID
1603603

Division
茨城事業所

Industry
Chemical, Raw Materials

Company Type
Large Company (more than 300 employees)

Job Type
Permanent Full-time

Location
Ibaraki Prefecture, U-shi Ku-shi

Salary
7.5 million yen ~ 13 million yen

Refreshed
November 19th, 2026 03:00

General Requirements

Minimum Experience Level
Over 6 years

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Basic Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

本ポジションでは、GaN基板製造の下地工程（種結晶＝シードの作製）におけるフォトリソグラフィ工程を中心に、プロセス改善・生産技術の確立をご担当いただきます。具体的には以下の通りです。

＜担当業務項目＞
プロセス開発・条件最適化 ：GaN（窒化ガリウム）基板の製造プロセスにおける、フォトリソグラフィー工程やドライ

エッチング工程の条件検討及び最適化を行い、高品質なGaN基板を安定的に生み出すダイナミックな業務です。サファイア基板へのMOCVDによる薄膜形成後、プラズマCVDによるマスク形成、フォトレジスト塗布、パターニング、現像、ドライエッチング、レジスト除去までの一連の工程を扱います。マスクの形状・幅・高さ・材質はその後のHVP結晶成長の品質に直結するため、条件検討・最適化がこの技術の核心です。
・評価データ、プロセスデータの解析、解析技術の開発
　自ら作成したサンプルを評価・解析し、結果を製造プロセスへ反映させます。
　専門的な知見を活かした高度な解析が、世界最高水準の製品の品質向上に直結する重要な役割です。
・化合物半導体のエピタキシャル成長技術の開発、国内外の社外委託先検討及び技術開発
　MOCVD等による薄膜形成の経験も大いに活かせる環境です。

Required Skills

【必須条件】
・理工系（物理、化学、化学工学、材料科学、機械工学、電気・電子工学　等）を専攻された方
・半導体・電子部品・化学・材料いずれかの業界における製造ないしは開発・生産技術の実務経験（目安3年以上）をお持ちの方
・下記のいずれかの実務経験（GaNに関する経験は特に歓迎。最先端の知見は不問で、基礎的なプロセス技術があれば可）
　- 半導体材料（GaN、SiC、Si、サファイア、脆性材料等）のフォトリソグラフィプロセスの経験
　- 金属膜、酸化膜等の成膜技術（プラズマCVDやスパッタ等）
・下記の能力を保有している方
　- 半導体材料のフォトリソグラフィ技術・成膜技術の専門知識を有する
　- 製造現場（オペレーター）を巻き込み、指示書をもとに工程を動かしていけるコミュニケーション力
　- 安全を最優先に業務を遂行する意識

【歓迎要件】
・物理、化学、化学工学、材料科学、機械工学、電気・電子工学を専攻された方
・化合物半導体（GaN、SiC等）のデバイス・基板の開発 / 量産に携わった経験をお持ちの方
・経験職種
- 化合物半導体の結晶成長技術（MOCVD等）の経験
- 化合物半導体の評価技術、熱・流体・構造の計算機シミュレーションの経験
- 将来的にチームを牽引するリーダー / マネジメントを志向される方（技術者でありながらマネジメントにも意欲のある方）
・語学力：英語

Company Description

国内最大手の石油化学メーカー